



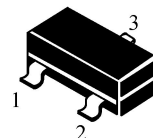
桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM8550

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

PNP Low Frequency Power Amplifier 低頻功率放大
 Suitable for Driver Stage of Small Motor 小馬達驅動
 Complementary to GM8050 与 GM8050 互补

■最大額定值(T_a=25°C)

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CBO}	-40 -25(GMA6801)	V
Collect-Emmitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	-25 -18(GMA6801)	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	-5.0	V
Collector Current 集電極電流	I _c	-500(S8550A,S8550) -1000(M8550) -1200(MMT8550) -1500(SS8550) -1800(GMA6801)	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P _c	225	mW
Junction Temperature 結溫	T _j	150	°C
Solder Temperature/Solder Time 焊接溫度/焊接時間	T/t	260/10	°C/S
Storage Temperature Range 儲存溫度	T _{stg}	-55~150	°C

■DEVICE MARKING 打標

S8550A=2TY. S8550=2TY M8550=Y2.
 MMT8550=Y2 SS8550=Y.2 GMA6801=6801



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM8550

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	—	—	-0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-100\mu\text{A}$ (GMA6801)	-40 (-25)	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10\text{mA}$ (GMA6801)	-25 (-18)	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-100\mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$H_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-50(\text{S8550/A})\text{mA}$ $V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	85	—	400	—
	$H_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1\text{V},$ $I_C=-1800\text{mA}(\text{GMA6801})$	50	—	—	
		$I_C=-800\text{mA}$ (SS8550, MMT8550, M8550)	40			
		$I_C=-500\text{mA}(\text{S8550})$ $I_C=-500\text{mA}(\text{S8550A})$	40 30			
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}(\text{S8550/A})$ $I_C=-1000\text{mA}, I_B=-100\text{mA}(\text{M8550})$ $I_C=-1200\text{mA}, I_B=-120\text{mA}(\text{MMT8550})$ $I_C=-1500\text{mA}, I_B=-150\text{mA}(\text{SS8550})$ $I_C=-1000\text{mA}, I_B=-100\text{mA}(\text{GMA6801})$	—	—	-0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}(\text{S8550/A})$ $I_C=-1000\text{mA}, I_B=-100\text{mA}(\text{M8550})$ $I_C=-1200\text{mA}, I_B=-120\text{mA}(\text{MMT8550})$ $I_C=-1500\text{mA}, I_B=-150\text{mA}(\text{SS8550})$ $I_C=-1800\text{mA}, I_B=-180\text{mA}(\text{GMA6801})$	—	-1	-1.2	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	—	-0.8	-1.0	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	100	120	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	13	30	pF